
	<p><b>SI4972DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4972DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4972DY-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 800800 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4972DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	800800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.5 mOhm @ 6A, 10V
Leistung - max	3.1W, 2.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 10.8A, 7.2A 3.1W,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.8A, 7.2A
Basisteilenummer	SI4972

SI4972DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4972DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4972DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4972DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4972DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4971DY-T1-E3</b> Original SI4971DY-T1-E3 Original</p>	 <p><b>SI4972DY</b> VISHIAY SI4972DY VISHIAY</p>	 <p><b>SI4972DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8SOIC</p>
 <p><b>SI4972DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4973DY-T1</b> VISHAY SI4973DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4973DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4973DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>

### SI4972DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4972DY-T1-GE3	SI4972DY-T1-GE3-Datenblatt	SI4972DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4972DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4972DY-T1-GE3
SI4972DY-T1-GE3 Electronic	SI4972DY-T1-GE3 Electronic	SI4972DY-T1-GE3 Komponenten	SI4972DY-T1-GE3-Verteiler	SI4972DY-T1-GE3-Bild	SI4972DY-T1-GE3 Bild	SI4972DY-T1-GE3-Teil
SI4972DY-T1-GE3 Preis	SI4972DY-T1-GE3 Hersteller	SI4972DY-T1-GE3 Original	SI4972DY-T1-GE3 garantiert	SI4972DY-T1-GE3 RFQ	SI4972DY-T1-GE3 Inventar	SI4972DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited